

2SD605

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

☆高耐圧ダーリントントランジスタ

○一般用

○通信産業用

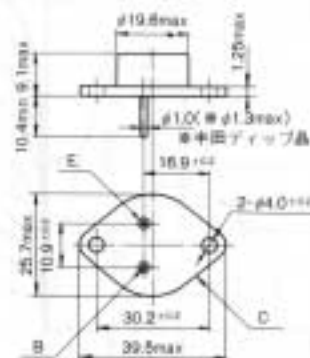
外形図

単位: mm

最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	2SD605	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	600	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	10	V
コレクタ電流	I_C	8	A
ベース電流	I_B	1	A
許容コレクタ損失	P_C	80 (フランジ温度 25°C)	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-65 - +150$	$^\circ\text{C}$

JEDEC (TO-3) EIAJ (TO-3-TB-3)



製品重量 約13g

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SD605	単位
最大コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 600\text{V}$	500	μA
最大エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 10\text{V}$	100	mA
最大コレクタ・エミッタ遮断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 500\text{V}$	1	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 2\text{V}$ $I_C = 4\text{A}$	200 min	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 4\text{A}$ $I_B = 40\text{mA}$	1.5 max	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 4\text{A}$ $I_B = 40\text{mA}$	2.0 max	V

$P_C - T_a$ 定格

